

1/34/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014473496

WPI Acc No: 2002-294199/200234

Molded body based on polycrystalline silicon carbide used in the production of a sliding ring seal in chemical apparatus and machines has a crystalline graphite layer on its surface

Patent Assignee: WACKER CHEM GMBH (WACK)

Inventor: KAYSER A; SCHWETZ K; THALER H

Number of Countries: 030 Number of Patents: 009

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1188942	A1	20020320	EP 2001121665	A	20010913	200234 B
CA 2357208	A1	20020314	CA 2357208	A	20010912	200234
DE 10045339	A1	20020404	DE 10045339	A	20000914	200234
JP 2002114585	A	20020416	JP 2001275584	A	20010911	200242
US 20020074744	A1	20020620	US 2001947798	A	20010906	200244
EP 1188942	B1	20020904				200266
CZ 200103321	A3	20020911	CZ 20013321	A	20010914	200268
DE 50100022	G	20021010	DE 100022	A	20010913	200269
			EP 2001121665	A	20010913	
US 6777076	B2	20040817	US 2001947798	A	20010906	200454

Priority Applications (No Type Date): DE 10045339 A 20000914

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 1188942	A1	G	13	F16C-033/04	
------------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR

CA 2357208	A1	E		C04B-035/565
------------	----	---	--	--------------

DE 10045339	A1			C04B-041/80
-------------	----	--	--	-------------

JP 2002114585	A		8	C04B-041/85
---------------	---	--	---	-------------

US 20020074744	A1			F16J-015/08
----------------	----	--	--	-------------

EP 1188942	B1	G		
------------	----	---	--	--

Designated States (Regional): AL DE GB IT LT LV MK RO SI

CZ 200103321	A3			C04B-035/565
--------------	----	--	--	--------------

DE 50100022	G			
-------------	---	--	--	--

Based on patent EP 1188942

US 6777076	B2			C04B-041/80
------------	----	--	--	-------------

Abstract (Basic): EP 1188942 A1

NOVELTY - Molded body based on polycrystalline silicon carbide has a crystalline graphite layer having a thickness of 0.1-100 μm on its surface. The layer is produced by the thermal decomposition of the silicon carbide after sintering to a closed porosity.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a process for the production of a silicon carbide molded body comprising heating a silicon carbide body with closed porosity to a temperature above the decomposition temperature of the silicon carbide in a vacuum or in a protective gas atmosphere. Preferred Features: The graphite layer has a thickness of 0.5-20.0 μm and a specific electrical resistance of 0.5-5.0, preferably 0.8-1.9 $\text{m}\Omega\text{cm}$.

USE - Used in the production of a sliding ring seal in chemical apparatus and machines (claimed).

ADVANTAGE - The body has high hardness, temperature resistance, heat conductivity, thermal shock resistance and oxidation and corrosion resistance.

pp; 13 DwgNo 0/4

Derwent Class: L02; P73; Q62; Q65

International Patent Class (Main): C04B-035/565; C04B-041/80; C04B-041/85;

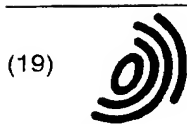
THIS PAGE BLANK (USPTO)

F16C-033/04; F16J-017/08
International Patent Class (Additional): B32B-005/16; C04B-035/64;
C04B-041/87; F16C-017/00; F16J-015/10; F16J-015/16

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2005 Thomson Derwent. All rights reserved.

© 2005 Dialog, a Thomson business

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 188 942 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
20.03.2002 Patentblatt 2002/12

(51) Int Cl.7: **F16C 33/04**

(21) Anmeldenummer: 01121665.2

(22) Anmeldetag: 13.09.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- Schwetz, Karl, Dr.
87477 Sulzberg (DE)
- Kayser, Armin
87474 Buchenberg (DE)

(30) Priorität: 14.09.2000 DE 10045339

(71) Anmelder: **Wacker-Chemie GmbH**
81737 München (DE)

(74) Vertreter: **Potten, Holger et al**
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente,
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)

(72) Erfinder:
• **Thaler, Hubert**
87437 Kempten (DE)

(54) **Mit Grafit beschichteter Formkörper aus gesintertem Siliciumcarbid**

(57) Formkörper auf Basis von polykristallinem SiC mit einer Dichte größer 90% seiner theoretischen Dichte und mit einer Grafitschicht an seiner Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die Grafitschicht kristallin ist, eine Dicke von 0,1 - 100 µm aufweist, und durch

oberflächliche thermische Zersetzung des SiC nach seiner Dichtsinterung bis auf geschlossene Porosität erzeugt wurde.

EP 1 188 942 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen mit Graphit beschichteten Formkörper aus gesintertem Siliciumcarbid.

[0002] Dichtes, gesintertes SiC zeichnet sich durch eine Kombination wertvoller Eigenschaften aus, wie hohe Härte und Verschleißfestigkeit, Hochtemperaturfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit, Thermoschockbeständigkeit, sowie Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften hat sich heute festphasengesintertes SiC als nahezu idealer Werkstoff für verschleißbeanspruchte Gleitlager sowie Gleitringdichtungen, z.B. im chemischen Appa-
rate- und Maschinenbau, eingeführt.

[0003] Aus US 5939185 vom 17.8.99 ist bekannt, daß SiC bei minimiertem Korngrenzengehalt auch gegen Heißwasser korrosionsresistent ist. Dies wird bewirkt durch ein bimodales, grobkristallines Plattengefüge des SiC so-
wie durch zusätzlich vorhandenen Graphit, welcher als partikuläre Begleitphase im gesamten SiC-Körper der Gleitring-
dichtung vorhanden ist. Dieser Graphit vermindert die tribochemische Korngrenzenkorrosion, die bei Wirktemperaturen
von über 200°C einsetzt. Nachteiligerweise zeigen Gleitringdichtungen aus diesem grobkristallinen Werkstoff eine sehr
lange Einlaufzeit (=200 h). Zudem zeigten sich auch mit diesem Gleitwerkstoff, wenn er elektrisch isoliert eingebaut
wurde, (z.B. als Gleitringdichtung in einer Speisewasserpumpe) Korrosionserscheinungen am SiC Ring, die chemisch
bzw. tribochemisch nicht erklärt werden konnten (Fig. 1). Die Kontur der geschädigten Ringform kann nicht über me-
chanische und chemische Angriffe entstehen. Es zeigten sich auch Schädigungen, die über die Funktionsflächen hin-
ausgehen, ohne daß eine mechanische Einwirkung stattfand. Entsprechende Korrosionserscheinungen wurden als
Elektrokorrosion bezeichnet (s. J.Nosowicz und A.Eiletz: "Operating performance of mechanical seals for boiler feed
pumps"; in: BHR-Conference of Fluid Sealing, Maastricht 1997, 341-351).

[0004] Probleme bei der Herstellung wie die Ribbildung bei der Formgebung und nachfolgendem Sintern von gra-
fithaltigem SiC lassen sich verhindern, wenn statt der Grafiteinlagerung in das SiC-Gefüge eine Graphit-Schicht auf die
Oberfläche des SiC-Sinterkörpers aufgebracht wird.

[0005] JP04041590 A von NIPPON CEMENT KK offenbart die Herstellung eines graphitbeschichteten SiC Formkör-
pers, bei dem die Graphitschicht durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) aus Kohlenwasserstoffen im Gemisch
mit Wasserstoff auf einem offenporigen SiC Formkörper gebildet wird. Das Verfahren ist aufwendig und teuer. Zudem
ist die mittels CVD Verfahren abgeschiedene Graphitschicht nicht fest auf der SiC Oberfläche verankert. Die CVD-Gra-
fitschicht dient vor allem zum Abdichten der offenen Porosität und als Schmiermittel, welches eine Verbesserung der
Gleiteigenschaft über Eintrag in die Poren des SiC bewirkt. Der SiC-Grundkörper muß dazu offenporig sein, da die
Poren wie Vorratsbehälter für das Gleitmittel Graphit wirken.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Formkörper aus gasdicht(=geschlossene Porosität) gesin-
tertem SiC einer Dichte größer 90% seiner theoretischen Dichte mit einer Graphitschicht an seiner Oberfläche zur Ver-
fügung zu stellen, bei dem die Graphitschicht fest mit dem SiC verbunden ist und bei dem die Elektrokorrosion verhindert
ist.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Formkörper aus polykristallinem SiC, der dadurch gekennzeichnet ist,
daß die Graphitschicht eine Dicke von 0,1 - 100 µm aufweist und durch oberflächliche thermische Zersetzung des SiC
nach seiner Dichtinterung bis auf geschlossene Porosität erzeugt wurde.

[0008] Vorzugsweise weist die Graphitschicht eine Dicke im Bereich von 0,5 - 20,0 µm auf. Vorzugsweise ist die Gra-
fitschicht einlagig.

Vorzugsweise weist die Graphitschicht einen spezifischen elektrischen Widerstand von 0,5 bis 5,0 mΩcm auf.

[0009] Besonders bevorzugt weist die Graphitschicht einen spezifischen elektrischen Widerstand von 0,8 bis 1,9
mΩcm auf.

[0010] Vorzugsweise befindet sich die Graphitschicht auf einer tribologisch wirksamen Funktionsfläche und/oder auf
einer tribologisch unwirksamen Mantelfläche des Formkörpers.

[0011] Auf den tribologisch wirksamen Funktionsflächen verbessert die Graphit-Schicht unter den Bedingungen der
Mischreibung bzw. des partiellen Trockenlaufs die Einlaufcharakteristik sowie den Reibwert des erfindungsgemäßen
Formkörpers.

[0012] Auf den Mantelflächen des Formkörpers verhindert die Graphitschicht die Elektrokorrosion. Es zeigte sich, daß
ein elektrisch isolierter Einbau eines bekannten SiC-Gleitlings zu einem Potentialaufbau und in folge daraus zu Kor-
rosionserscheinungen am SiC Ring führt. Diese elektrische Korrosion läßt sich durch eine Ableitung des Potentials
über eine elektrisch leitfähige Kontaktierung des SiC-Gleitlings verhindern. Da ein SiC Formkörper aufgrund des hohen
spezifischen Widerstandes des SiC von etwa 1-10⁴ Ωcm keine ausreichende Oberflächenleitfähigkeit aufweist, ist die
Ableitung des Potentials mit einem herkömmlichen SiC Material nicht gesichert möglich. Bei dem erfindungsgemäßen
Formkörper erfolgt die Ableitung über die gut haftende elektrisch leitfähige Graphitschicht an der Oberfläche des Form-
körpers.

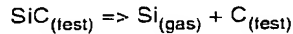
[0013] Der erfindungsgemäße Formkörper besteht aus einem üblichen SiC Sinterkörper mit geschlossener Porosität,
welcher mit einer durch oberflächliche Zersetzung erzeugten Graphitschicht einer Dicke von 0,1 bis 100 µm bedeckt ist.

[0014] Vorzugsweise besteht der erfindungsgemäße Formkörper aus 77-99,7 Masse% polykristallinem SiC, einer

SiC-Kristallitgröße von 1 bis 2000 µm, sowie 0,2-5,0 Masse% Bor, Borverbindungen, Al, Al-Verbindungen, sowie 0,1-25,0 Masse% zusätzlichem Kohlenstoff (in Form von amorphem Kohlenstoff und/oder Grafit), wobei der Formkörper ggf. eine Gesamtporosität von bis zu 10 Vol% in Form unabhängiger geschlossener Poren aufweist.

[0015] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Formkörpers.

[0016] Dieses Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß ein üblicher SiC-Sinterkörper mit geschlossener Porosität auf eine Temperatur oberhalb der Zersetzungstemperatur des SiC unter Vakuum oder unter Schutzgasatmosphäre (Ar, He etc.) erhitzt wird. Die oberflächliche thermische Zersetzung des dichtgesinterten SiC-Formkörpers erfolgt gemäß



[0017] Der gebildete Kohlenstoff verbleibt als Grafit an der Oberfläche (siehe Fig. 2), während das gebildete Silicium durch die Grafitschicht verdampft und in kalten Ofenbereichen kondensiert.

[0018] Der im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Formkörper kann nach einem beliebigen, drucklosen Sinterverfahren hergestellt worden sein.

[0019] Vorzugsweise wird beim erfindungsgemäßen Verfahren ein üblicher SiC-Sinterkörper mit geschlossener Porosität auf eine Temperatur zwischen 1600°C und 2200°C, vorzugsweise auf 1800°C bis 2000°C, erhitzt. Bei dieser Temperatur wird er für einen Zeitraum von 10 bis 180 min -vorzugsweise von 30 bis 90 min-gehalten. Während dieser Zeit erfolgt die Bildung der Grafitschicht an der Oberfläche.

[0020] Vorzugsweise wird während des Verfahrens ein Ofeninnendruck von 1000 mbar bis 10⁻⁵ mbar -vorzugsweise 1 bis 50 mbar-aufrechterhalten.

[0021] Anschließend wird der beschichtete Formkörper in üblicher Weise auf Raumtemperatur abgekühlt.

[0022] Bei der erfindungsgemäßen Grafitschicht handelt es sich überwiegend um hexagonalen 2H-Grafit. Dies ist aus Röntgenbeugungsdiagrammen, von bei 1800°C - 2000°C in Vakuum zersetzten SiC-Oberflächen aus den 3 Reflexen bei 2θ = 26,6 °/45,4° und 54,7° (CuKα-Strahlung) zu erkennen. Die Dicke der Grafitschicht läßt sich durch Variation der Prozeßparameter Temperatur / Haltezeit / Druck innerhalb der genannten Grenzen gezielt einstellen. Dies ist im Balkendiagramm in Fig.3 anschaulich dargestellt.

[0023] Der spezifische elektrische Widerstand (Fig.4) des Grafits als Funktion der Bildungstemperatur zeigt kein kontinuierlich steigendes oder fallendes Verhalten. Im erfindungsgemäßen Verfahren laufen also 2 Mechanismen gegenläufig ab, die zu einem Widerstandsmaximum führen. Das Maximum bei 1,8 mΩcm entspricht dabei der handelsüblichen Reinstgrafitsorte EK88 der Fa Ringsdorf (Bonn).

[0024] Bei 1600°C und weniger bilden sich auch bei sehr gutem Vakuum (10⁻³mbar) keine C-Schichten mehr und über 2050°C wird die Zersetzung von SiC unter 10 mbar Ofeninnendruck zu groß. Bis 2200°C kann hierbei mit Ar-Partialdruck bis Umgebungsdruck gegengesteuert werden.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren kann unmittelbar im Anschluß an das übliche Dichtsintern zur Herstellung eines SiC-Formkörpers durchgeführt werden, es ist jedoch ebenso möglich, das Verfahren erst im Anschluß an die Hartbearbeitung des gesinterten Formkörpers durchzuführen.

[0026] Das erstgenannte Verfahren ist aus Kostengründen vorteilhaft, da es im gleichen Sinterzyklus wie die Herstellung des Ausgangssinterkörpers durchgeführt werden kann. Es ist allerdings nur dann durchführbar, wenn der gesinterte Formkörper vor Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ohne Nachbearbeitung bereits die für die jeweilige Anwendung geforderten Spezifikationen (z.B. Rauhgkeit, maßliche Toleranzen wie -Durchmesser-Höhe-Wandstärke) erfüllt. Dabei geht man vorzugsweise wie folgt vor: Im Anschluß an die in bekannter Weise durchgeführte Dichtsinterung eines SiC-Sinterkörpers werden die Parameter Temperatur/Haltezeit und Ofeninnendruck wie genannt gewählt. Dabei bildet sich durch Zersetzung des SiC die Grafitschicht bereits in der Abkühlphase des Sinterzyklus.

[0027] Falls zur Erfüllung der von der jeweiligen Anwendung geforderten Spezifikationen (Abmessungen, Oberflächenrauigkeit) eine Hartbearbeitung des gesinterten SiC Formkörpers erforderlich ist, so wird das erfindungsgemäße Verfahren erst nach dieser Hartbearbeitung durchgeführt. Es ist dann erforderlich, das erfindungsgemäße Verfahren als einen eigenen Verfahrensschritt durchzuführen. Dieser wird vorteilhafterweise mit einer hohen Stückzahl von zu beschichtenden SiC Formkörpern in einem zur SiC Sinterung üblichen Ofenaggregat durchgeführt.

[0028] Im Anschluß an das erfindungsgemäße Verfahren sind keine zusätzlichen Qualitätsprüfungen notwendig da bei den im erfindungsgemäßen Verfahren angewendeten Glühtemperaturen keine Änderung der Abmessungen bzw. kein Verzug des SiC-Formkörpers mehr auftritt.

[0029] Die unkontrollierte Bildung von Grafitschichten beim Sintern von SiC im Vakuum wird in der japanischen Patentschrift JP59184769 A von Hitachi CHEM. Co LTD beschrieben. In dieser Schrift wird allerdings explizit gefordert, beim Sintern eines SiC Sinterkörpers ab 1800°C zur Verhinderung der Zersetzung des SiC und zur Vermeidung einer unerwünschten Kohlenstoff-Zersetzungsschicht das SiC mit höherem Ar-Partialdruck zu sintern. Im Gegensatz zum erfindungsgemäßen Verfahren, in dem die oberflächliche Zersetzung kontrolliert erst nach der Dichtsinterung, d.h. im

Stadium der geschlossenen Porosität, bewerkstelligt wird, erfolgt hier die oberflächliche Zersetzung von SiC unter Bildung von Grafit bereits frühzeitig während des Drucklossintervorganges, was zu unerwünscht dicken und lokal inhomogenen Schichtdicken führt. Der in dieser Anmeldung in einem Vergleichsbeispiel genannte grafitbeschichtete SiC Sinterkörper ist als Gleitwerkstoff ungeeignet, da die Grafitschicht eine Dicke von 500 µm hat. Eine Grafitschicht in dieser Stärke ist inhomogen und nicht fest mit dem darunterliegenden SiC verbunden. Diffusionsprobleme des gasförmigen Siliciums durch die sich bildende Grafitschicht bewirken mit zunehmender Schichtdicke Spannungsrißprobleme sowie Blasenbildung an der Grenze zwischen SiC und Grafit, wodurch die Tendenz zum Abplatzen der Grafit-schicht vom SiC Grundkörper zunimmt. Allgemein gilt, daß sich die Abplatzneigung proportional zur Schichtdicke verhält.

[0030] Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung eines erfindungsgemäßen Formkörpers als Verschleißteil sowie ein Verschleißteil, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß es aus einem erfindungsgemäßen Formkörper besteht. Bei den Verschleißteilen handelt es sich vorzugsweise um Ring oder Gegenring einer mechanischen Gleitringdichtung, oder um Lagerteile. Die Erfindung betrifft zudem Gleitringdichtungen, die ein erfindungsgemäßes Verschleißteil enthalten.

Beispiele für solche Dichtungen sind im folgenden genannt:

[0031] Eine Gleitringdichtung, bestehend aus einem SiC-Gleitring und einem Kohlegrazit-Gegenring, die dadurch gekennzeichnet ist, daß der SiC-Gleitring ein erfindungsgemäßer Formkörper ist.

[0032] Eine Gleitringdichtung, bestehend aus einem SiC-Gleitring und einem SiC-Gegenring, dadurch gekennzeichnet, daß der SiC-Gleitring oder der SiC-Gegenring ein erfindungsgemäßer Formkörper ist. In einer Variante dieser Gleitringdichtung liegt in Gleitring und Gegenring ein SiC-Gefüge mit bimodaler Verteilung bestehend aus äquiauxialen oder plattenförmigen Kristalliten eines Durchmessers bis 50 µm und plattenförmigen Kristalliten einer Länge bis 2000 µm vor.

[0033] In einer weiteren Variante dieser Gleitringdichtung liegt in Gleit- und Gegenring ein monomodales, feinkörniges SiC-Gefüge mit Kristallitdurchmesser bis zu 10 µm vor. Dabei ist einer der beiden Ringe ein erfindungsgemäßer Formkörper. In einer anderen Variante einer erfindungsgemäßen Gleitringdichtung, bestehend aus einem rotierenden SiC-Gleitring und einem stationären SiC-Gegenring, besteht der rotierende Gleitring aus monomodalem, feinkörnigen SiC-Gefüge eines Durchmessers bis zu 10 µm und der stationäre Gegenring aus bimodalem grobkörnigen Plattengefüge mit einer Plattenlänge bis zu 2000 µm, wobei die Funktionsfläche mindestens eines Ringes eine Grafitschicht aufweist. In einer anderen Variante einer erfindungsgemäßen Gleitringdichtung, bestehend aus einem rotierenden SiC-Gleitring und einem stationären SiC-Gegenring weist mindestens einer der Ringe ein Gefüge mit kugelförmigen, abgeschlossenen Poren der Größe 40 - 100 µm auf, und mindestens einer der Ringe weist eine Grafitschicht auf.

[0034] Bevorzugt wird ein erfindungsgemäßer grafitbeschichteter SiC Formkörper in einer hart/hart-Paarung angewendet.

[0035] Ein erfindungsgemäßer grafitbeschichteter SiC Formkörper ist im Dichtungsbereich auch für hart/weich-Paarungen geeignet.

[0036] Hart/hart bedeutet, daß Ring und Gegenring aus einem gesinterten Hartstoff bestehen; z.B. Ring und Gegenring sind aus SiC wobei ein erfindungsgemäß beschichteter SiC Ring auch als hart gilt.

[0037] Hart/weich bedeutet, daß ein Ring aus einem Hartstoff besteht und der gegenüberliegende Ring aus Kohlegrazit besteht. (z.B. Gleitring aus SiC und Gegenring aus Kohlegrazit).

[0037] Auch auf hartbearbeiteten Funktionsflächen wirkt eine Grafitschicht positiv auf das Einlaufverhalten der Dichtung. Bei der weiteren Nutzung in einer Dichtung verhindert die Grafitschicht auch die hydrothermale Korngrenzenkorrosion. Sie verlängert somit die Lebensdauer einer Gleitringdichtung.

[0038] Als weiterer positiver Effekt zeigte sich, daß ein grobkörniges, besonders korrosionsbeständiges SiC (käuflich erhältlich bei der Firma ESK (Kempten) unter der Bezeichnung EKasic W) nachdem es erfindungsgemäß mit einer Grafitschicht versehen wurde, auch gegen feinkörniges SiC hervorragend läuft. Die mechanische Belastung, insbesondere beim Anfahren, ist hier von Anfang an gering. Da die Ursache für einen zu frühen Ausfall überwiegend in der Anfahrphase (=hoher Mischreibungsbereich) liegt, kann auf diese Weise der prozentuelle Anteil Funktionsausfall drastisch gesenkt werden. So eine Anfangsschädigung wird mit unbeschichteten hart/hart-Paarungen, insbesondere bei Gleitringdichtungen, aus SiC-Werkstoffen mit unterschiedlichen Gefügen häufig beobachtet.

[0039] Die Grafitschicht auf EKasic W verbessert auch in anderer Hinsicht das Einlaufverhalten einer Gleitringdichtung. Die Einlaufcharakteristik dieses Werkstoffes ist normalerweise etwas ruppig. Die Grafitbeschichtung der Funktionsfläche korrigiert dies zu einer ruhigen und gleichmäßigen Startphase und verringert gleichzeitig weiter die Anfälligkeit gegen Korngrenzenangriff.

[0040] Die gute elektrische Leitfähigkeit der Grafitschicht verhindert durch oberflächliche Ableitung einen Potentialaufbau, so daß Elektrokorrosion nicht auftreten kann.

[0041] Fig.1 zeigt eine typische Form der Elektrokorrosion an einer im praktischen Einsatz benutzten Gleitringdich-

tung gemäß Stand der Technik im Querschnitt. Der Gleitring (EKasic D unbeschichtet) wurde während des Gebrauchs ausgehöhlt, während sich in den Gegenring (EKasic D unbeschichtet) nur die beiden überstehenden Kanten innen und außen einarbeiteten. Die mittige Fläche des Gegenringes blieb fast unberührt.

[0042] Fig. 2 zeigt die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Bruchfläche eines erfindungsgemäßen mit Grafit beschichteten Gleitringes aus drucklos gesintertem SiC. Die Grafitschicht wurde durch das erfindungsgemäße Verfahren (Druck 10 mbar / Temperatur 1900°C / Haltezeit 90 min) erzeugt. Deutlich ist die ca. 6 µm dicke Grafitschicht zu erkennen.

[0043] Fig.3 zeigt die Schichtdicken erfindungsgemäßer Grafitschichten auf SiC

- a) als Funktion der Glüh Temperatur bei 30 min Haltezeit
b) als Funktion der Haltezeit bei 1850°C und 1900°C

[0044] Fig.4 zeigt den spezifischen elektrischen Widerstand einer erfindungsgemäßen Grafitschicht

- a) als Funktion der Glüh Temperatur bei 30min Haltezeit
b) als Funktion der Haltezeit bei 1850°C und 1900°C

[0045] Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele weiter erläutert:

Beispiele 1 - 9 Erzeugung von erfindungsgemäßen Sinterkörpern

[0046] Drucklos gesinterte SiC-Formkörper der Sinterdichte $\geq 3,10 \text{ g/cm}^3$ wurden mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens mit einer Grafitschicht versehen. Das Verfahren wurde in einem Hochtemperatur-Vakuum-Ofen mit Grafitaufbau durchgeführt. Die SiC-Sinterkörper wurden zunächst in 60 min unter Rotationspumpenvakuum im Bereich 1-10 mbar auf 1050°C erhitzt, im Pyrometer-geführten Temperaturprogramm anschließend in ca 80 min auf 1700°C erhitzt (entspricht einer Aufheizrate von ca. 500°C/h) und in weiteren 15 min auf 1800°C (entspricht einer Aufheizrate von 400°C/h) erhitzt.

[0047] Ab hier wurde die variable Zieltemperatur der Beispiele 1-9 (1800°C - 2000°C; siehe Tab. 1), mit einer Aufheizrate von 300°C/h angefahren. In diesen Beispielen wurde die Haltezeit von 30- auf 60- auf 90 min bei 2 mittleren Temperaturen variiert (siehe Tab. 1). Die variablen Versuchsparmeter Temp/Haltezeit sind in Tab.1 wiedergegeben. Die elektr. Leitfähigkeit und der spez. elektr. Widerstand der Grafitschicht der so erhaltenen erfindungsgemäßen grafitbeschichteten SiC Formkörper sind ebenfalls in Tab. 1 wiedergegeben.

[0048] Die Schichtbildungstemperaturen sind stark vom Atmosphärendruck abhängig. So konnten bereits bei 1780°C und unter einem Druck von 1×10^{-1} mbar Grafitschichten erzeugt werden. Unter einem Ar-Partialdruck von ca. 300 mbar erfolgte die Schichtbildung erst bei 2150°C. Vorzugsweise werden Gasdrücke zwischen 1 und 10 mbar bei Temperaturen von 1800°C bis 2000°C angewendet

Tab.1:

Elektrische Leitfähigkeit bzw spezifischer elektrischer Widerstand von C-Schichten auf SiC gemessen nach Van der Pauw **				
Beispiel	Temperatur/Haltezeit	C-Schicht	Leitfähigkeit	Widerstand
	°C/min *	D in µm	kS/m	Ωcm
1	1800/30	0,9	69,1	$1,45 \cdot 10^{-3}$
2	1850/30	2,1	59,2	$1,69 \cdot 10^{-3}$
3	1850/60	3,0	72,1	$1,39 \cdot 10^{-3}$
4	1850/90	5,1	63,9	$1,57 \cdot 10^{-3}$
5	1900/30	4,9	56,2	$1,78 \cdot 10^{-3}$
6	1900/60	5,1	79,6	$1,26 \cdot 10^{-3}$
7	1900/90	6,4	82,0	$1,22 \cdot 10^{-3}$
8	1950/30	5,8	89,3	$1,12 \cdot 10^{-3}$

*bei 1-10 mbar

**4-Punktmeßmethode, Kontaktabstände 10,00mm, (Microvoltmeter Marke:Kethley, Typ 197 A)

Tab.1: (fortgesetzt)

Elektrische Leitfähigkeit bzw spezifischer elektrischer Widerstand von C-Schichten auf SiC gemessen nach Van der Pauw **				
Beispiel	Temperatur/Haltezeit	C-Schicht	Leitfähigkeit	Widerstand
	°C/min *	D in μm	kS/m	Ωcm
9	2000/30	7,8	116,4	$0,86 \cdot 10^{-3}$
Vergleich	SiC-Oberfläche	($\approx 0,1$)	0,05	$2 \cdot 10^3$

*bei 1-10 mbar

**4-Punktmeßmethode, Kontaktabstände 10,00mm, (Microvoltmeter Marke:Keithley, Typ 197 A)

[0049] Beispiel 10-11 Einsatz der erfindungsgemäßen Gleitringe auf einem Prüfstand der Fa. Burgmann.

Beispiel 10:

[0050] Eine erfindungsgemäße Gleitringdichtung (erfindungsgemäßer Gleitring: SSiC mit feinkörnigem äquialen Gefüge und einer 5 μm dicken Grafitschicht/ Gegenring: SSiC mit feinkörnigem äquialen Gefüge) wurde in einer mit 12 bar direkt belasteten Dichtung in voll entsalztem Wasser eingesetzt. Nach 48h mit einer Gleitgeschwindigkeit von 7,6 m/sec wurde der Versuch unterbrochen und nach weiteren 500 h Laufzeit beendet. Es zeigte sich, daß die Einlaufzeit fast gegen 0 geht, da sich von Anfang an ein sehr ruhiges und gleichmäßiges Laufbild einstellt. Eine keramografische Untersuchung der Funktionsflächen nach 48h wie auch nach weiteren 500 h zeigte eine ungeschädigte Laufspur.

Beispiel 11:

[0051] Eine erfindungsgemäße Gleitringdichtung (Gleitring gemäß Stand der Technik: SSiC mit feinkörnigem äquialen Gefüge/ erfindungsgemäßer Gegenring: grobkörniges Gefüge mit bis 2000 μm großen Platten aus SiC käuflich erhältlich unter der Bezeichnung EKasid® W aber versehen mit einer 5 μm dicken Grafitschicht) wurde in einer mit 12 bar direkt belasteten Dichtung in voll entsalztem Wasser eingesetzt. Nach 48h mit einer Gleitgeschwindigkeit von 7,6 m/sec wurde der Versuch unterbrochen und nach weiteren 500 h Laufzeit beendet.

[0052] Das Einlaufverhalten der Dichtung entsprach Bsp. 10. Dieses Beispiel belegt besonders gut die vorteilhafte Auswirkung der Grafitschicht, eine Gleitringkombination wie hier eingesetzt, aber ohne Grafitschicht, zeigt unter diesen Laufbedingungen schon nach 48 h Beschädigungen der Funktionsflächen.

[0053] Die keramografische Untersuchung der Funktionsflächen zeigte selbst nach 500 h Laufzeit keine derartigen Schädigungen, sondern ideal eingelaufene Funktionsflächen.

Patentansprüche

- Formkörper auf Basis von polykristallinem SiC mit einer Dichte größer 90% seiner theoretischen Dichte und mit einer Grafitschicht an seiner Oberfläche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Grafitschicht kristallin ist, eine Dicke von 0,1 - 100 μm aufweist, und durch oberflächliche thermische Zersetzung des SiC nach seiner Dichtsinterung bis auf geschlossene Porosität erzeugt wurde.
- Formkörper gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Grafitschicht eine Dicke im Bereich von 0,5 - 20,0 μm aufweist.
- Formkörper nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Grafitschicht einen spezifischen elektrischen Widerstand von 0,5 bis 5,0 $\text{m}\Omega\text{cm}$ aufweist.
- Formkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Grafitschicht einen spezifischen elektrischen Widerstand von 0,8 bis 1,9 $\text{m}\Omega\text{cm}$ aufweist.
- Formkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** er aus

77-99,7 Masse% SiC einer SiC-Kristallitgröße von 1 bis 2000 μm sowie

0,2-5,0 Masse% Bor, Borverbindungen, Al, Al-Verbindungen, sowie
0,1-25,0 Masse% zusätzlichem Kohlenstoff (in Form von amorphem Kohlenstoff und/oder Grafit) besteht,

wobei der Formkörper ggf. eine Gesamtporosität von bis zu 10 Vol% in Form unabhängiger geschlossener Poren aufweist.

6. Verfahren zum Herstellen eines SiC Formkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein SiC-Sinterkörper mit geschlossener Porosität auf eine Temperatur oberhalb der Zersetzungstemperatur des SiC unter Vakuum oder unter Schutzgasatmosphäre erhitzt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** der SiC-Formkörper auf eine Temperatur zwischen 1600°C und 2200°C erhitzt wird und bei dieser Temperatur für einen Zeitraum von 10 bis 180 min gehalten wird.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein Gasdruck von 1000 mbar bis 10⁻⁵ mbar - aufrechterhalten wird.
9. Verwendung eines Formkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 5 als Verschleißteil.
10. Verschleißteil, **dadurch gekennzeichnet, daß** es aus einem Formkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 besteht.
11. Gleitringdichtung, enthaltend ein Verschleißteil gemäß Anspruch 10.
12. Gleitringdichtung gemäß Anspruch 11, bestehend aus einem SiC-Gleitring und einem Kohlegrafit-Gegenring, **dadurch gekennzeichnet, daß** der SiC-Gleitring ein Formkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 ist.
13. Gleitringdichtung gemäß Anspruch 11, bestehend aus einem SiC-Gleitring und einem SiC Gegenring, **dadurch gekennzeichnet, daß** der SiC-Gleitring oder der SiC Gegenring ein Formkörper gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 ist.
14. Gleitringdichtung gemäß Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** in Gleitring und Gegenring ein SiC-Gefüge mit bimodaler Verteilung bestehend aus äquiaxialen oder plattenförmigen Kristalliten eines Durchmessers bis 50 µm und plattenförmigen Kristalliten einer Länge bis 2000 µm vorliegt.
15. Gleitringdichtung gemäß Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** in Gleitring und Gegenring ein monomodales feinkörniges Gefüge vorliegt mit einem Kristallitdurchmesser von <10 µm.
16. Gleitringdichtung gemäß Anspruch 11, bestehend aus einem rotierenden SiC-Gleitring und einem stationären SiC-Gegenring, **dadurch gekennzeichnet, daß** der rotierende Gleitring zu mindestens 98 Vol% aus monomodalem, feinkörnigen SiC-Gefüge mit einem Kristallitdurchmesser bis zu 10 µm besteht und der stationäre Gegenring aus bimodalem grobkörnigen Plattengefüge mit einer Plattenlänge bis zu 2000 µm besteht, wobei die Funktionsfläche mindestens eines Ringes eine Grafitschicht aufweist.
17. Gleitringdichtung, bestehend aus einem rotierenden SiC-Gleitring und einem stationären SiC-Gegenring, **dadurch gekennzeichnet, daß** mindestens einer der Ringe ein Gefüge mit kugelförmigen, abgeschlossenen Poren der Größe 40 - 100 µm und mindestens einer der Ringe eine Grafitschicht aufweist.

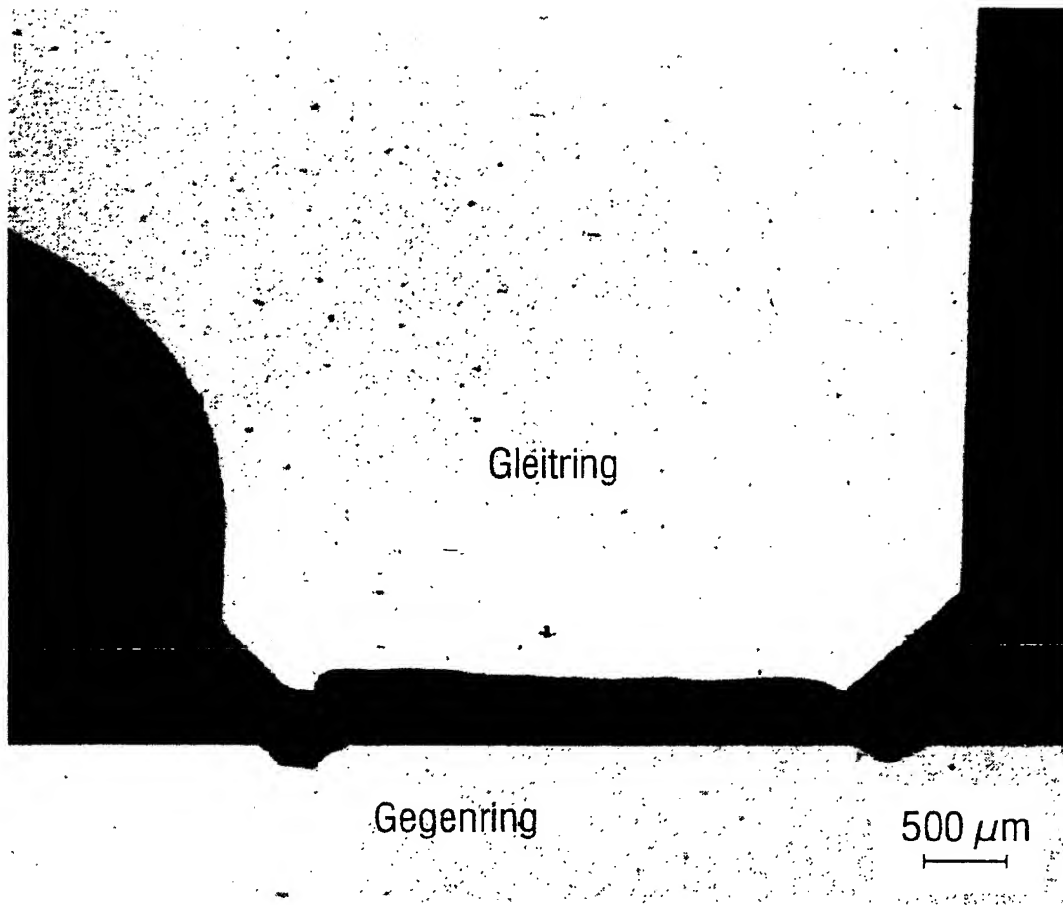


Fig. 1: Lichtmikroskopische Aufnahme von
Anschliffen korrodierter SSiC-Dichtungsringe
(Anschliffrichtung: senkrecht zur
Funktionsfläche)

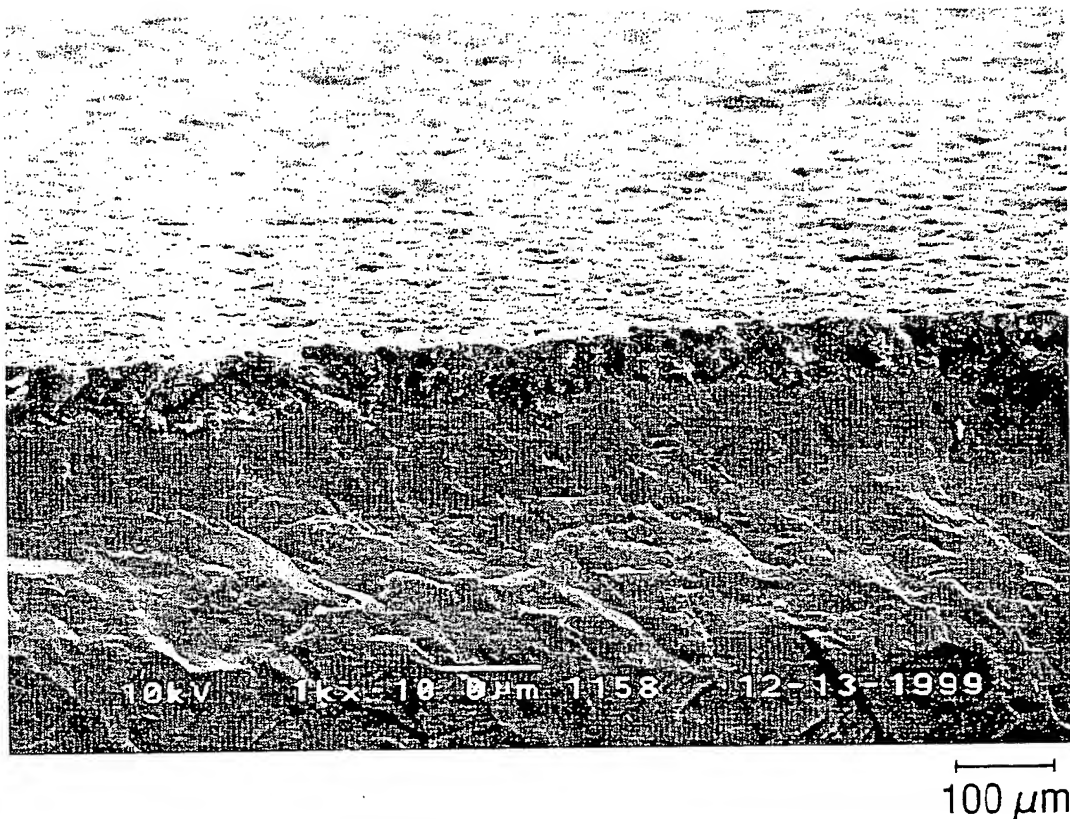


Fig. 2: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Bruchfläche eines SSiC-Gleitringes mit erfindungsgemäßer, festverankerter Grafitschicht (1900°C/90min)

Fig. 3a

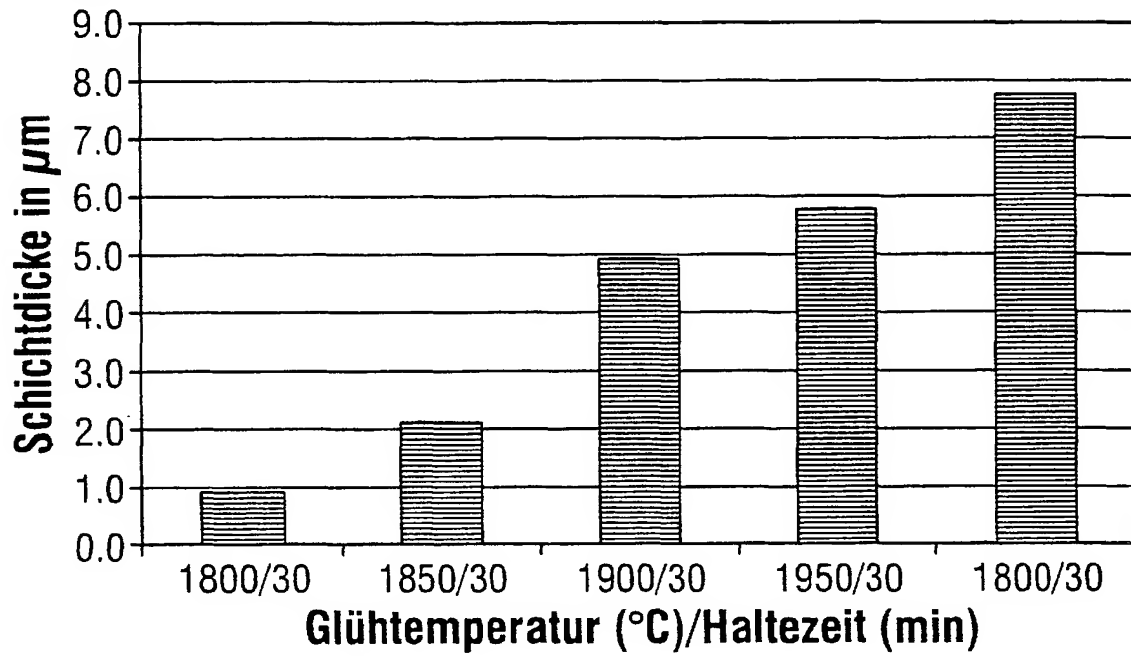


Fig. 3b

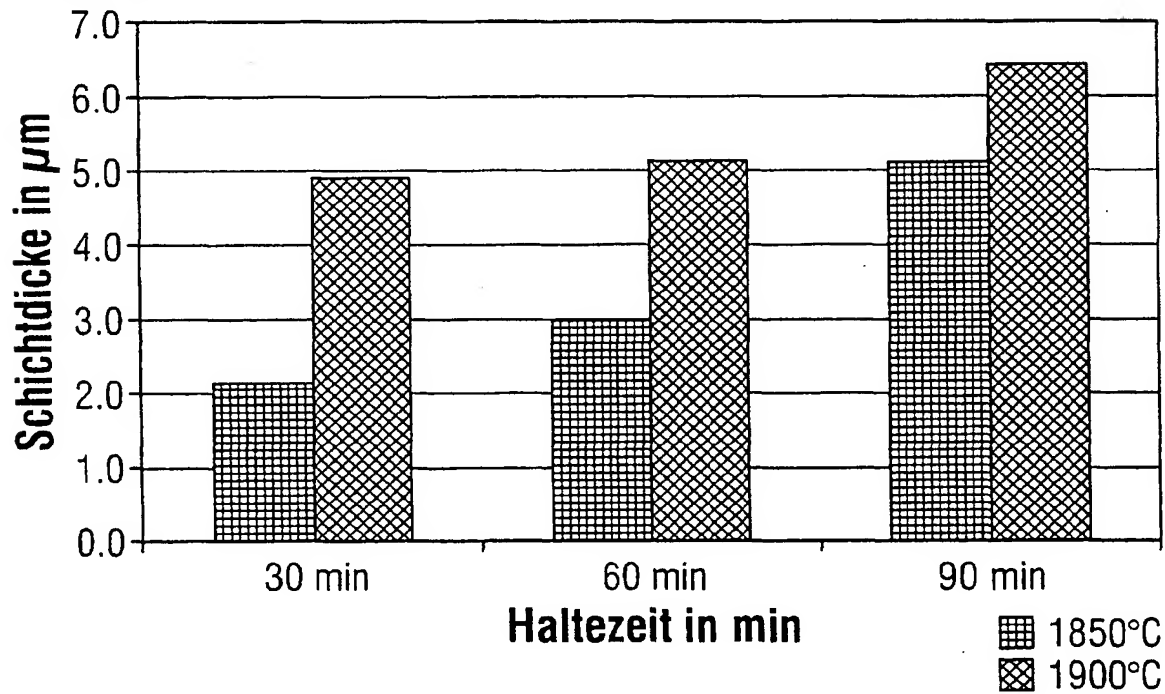
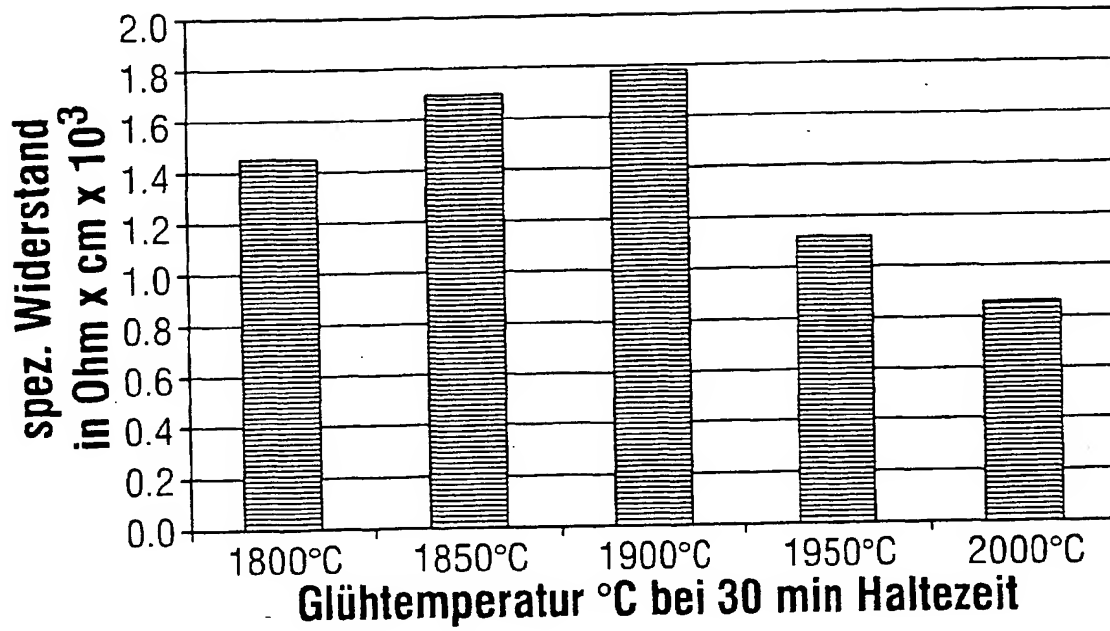
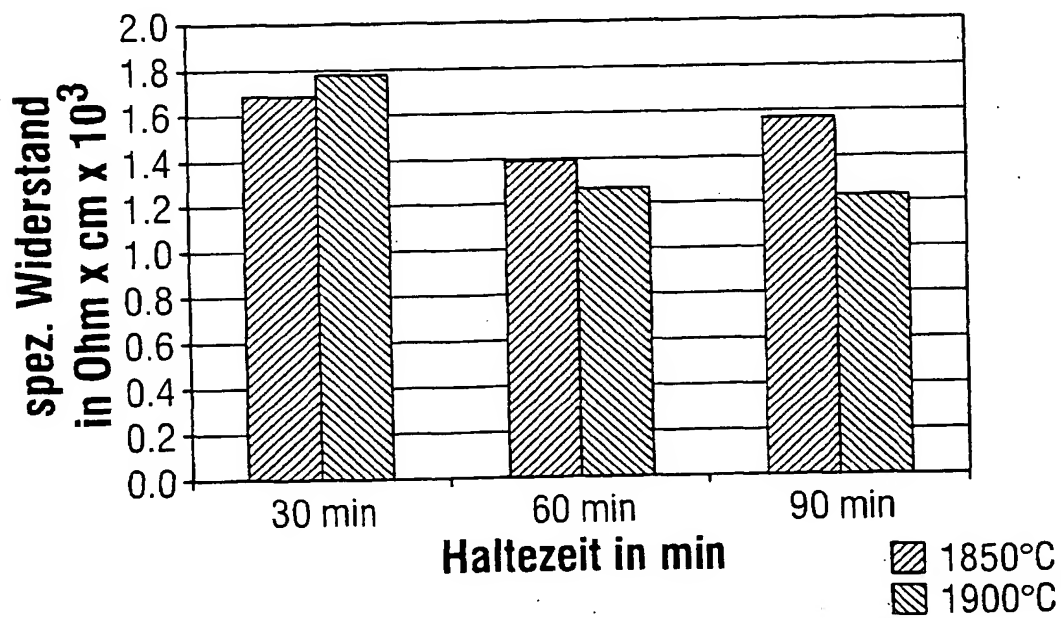


Fig. 4a**Fig. 4b**



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 12 1665

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	EP 0 578 408 A (CARBORUNDUM CO) 12. Januar 1994 (1994-01-12) * das ganze Dokument *	1,7	F16C33/04
A	EP 0 497 345 A (KYOCERA CORP) 5. August 1992 (1992-08-05) * das ganze Dokument *	1,2,7	
A	US 5 656 213 A (SAKAGUCHI MIKIO ET AL) 12. August 1997 (1997-08-12) * das ganze Dokument *	1	
A	DATABASE WPI Section Ch. Week 198448 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class L02, AN 1984-297768 XP002182478 & JP 59 184769 A (HITACHI CHEM CO LTD), 20. Oktober 1984 (1984-10-20) * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) F16C C04B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Patent	
BERLIN	12. November 2001	Hoffmann, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : vor besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : vor besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtchriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 12 1665

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

12-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument:	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0578408 A	12-01-1994	US 5395807 A	07-03-1995
		AT 191902 T	15-05-2000
		BR 9302802 A	16-02-1994
		CA 2098363 A1	09-01-1994
		DE 69328394 D1	25-05-2000
		DE 69328394 T2	31-08-2000
		EP 0578408 A2	12-01-1994
		JP 7033550 A	03-02-1995
		MX 9304083 A1	29-04-1994
		US 5635430 A	03-06-1997
		US 5589428 A	31-12-1996
		US 5834387 A	10-11-1998
EP 0497345 A	05-08-1992	JP 2738596 B2	08-04-1998
		JP 4270174 A	25-09-1992
		JP 2801785 B2	21-09-1998
		JP 4254473 A	09-09-1992
		JP 2902796 B2	07-06-1999
		JP 4254471 A	09-09-1992
		JP 2851717 B2	27-01-1999
		JP 4293998 A	19-10-1992
		JP 2784280 B2	06-08-1998
		JP 5009074 A	19-01-1993
		DE 69223528 D1	29-01-1998
		DE 69223528 T2	23-07-1998
		EP 0497345 A2	05-08-1992
		US 5462813 A	31-10-1995
		US 5571611 A	05-11-1996
US 5656213 A	12-08-1997	JP 3035720 B2	24-04-2000
		JP 5009055 A	19-01-1993
		JP 3048687 B2	05-06-2000
		JP 6048836 A	22-02-1994
		DE 4221318 A1	14-01-1993
JP 59184769 A	20-10-1984	JP 61000308 B	07-01-1986

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)